

KRYSTAL[®] Wafer 標準品

KRYSTAL[®] Wafer

独自開発の ZrO₂ Buffer(下地層)を使用することにより、上に成膜する様々な圧電材料を単結晶化し、高性能化することができる優れた圧電 MEMS 用ウエハーです。

一般的な圧電薄膜と比較して KRYSTAL[®] Wafer 単結晶圧電薄膜は、電氣的、機械的に優れた特性を発揮します。

I-PEX Piezo Solutions が提供する標準仕様 KRYSTAL[®] Wafer の Si 基板は下記の通りです。

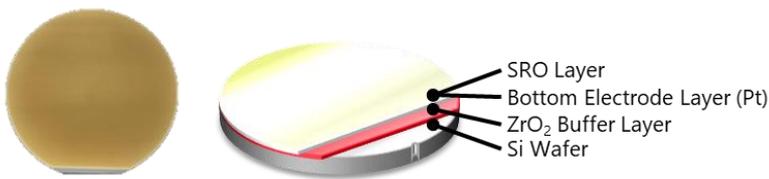
- 上部電極付 PZT(Actuator タイプ)Si 基板

上部電極付PZT (アクチュエータ) Si基板 イメージ	薄膜層構成	標準膜厚仕様	
	上部Pt層	100nm (目標値)	
	上部SRO層	10nm (目標値)	
	PZT層(Actuator)	2000nm ± 10%	
	下部SRO層	40nm ± 10%	
	下部Pt層	150nm ± 10%	
	ZrO2層	60nm ± 10%	
	標準品製品名	製品型番	基板サイズ
KRYSTAL Wafer-TE PZT(A20)-6-Si(100)	RF200-6F00	6inch	625 μm
KRYSTAL Wafer-TE PZT(A20)-8-Si(100)	RF300-8F00	8inch	725 μm

- PZT(Actuator タイプ)Si 基板

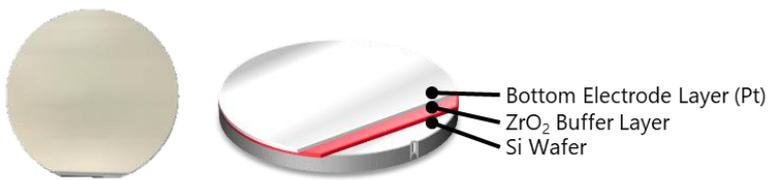
PZT (アクチュエータタイプ) Si基板 イメージ	薄膜層構成	標準膜厚仕様	
	—	—	
	—	—	
	PZT層(Actuator)	2000nm ± 10%	
	下部SRO層	40nm ± 10%	
	下部Pt層	150nm ± 10%	
	ZrO2層	60nm ± 10%	
製品名	製品型番	基板サイズ	ベース基板厚
KRYSTAL Wafer-PZT(A20)-6-Si(100)	RF200-6D00	6inch	625 μm
KRYSTAL Wafer-PZT(A20)-8-Si(100)	RF300-8D00	8inch	725 μm

● SRO/Pt 下部電極 Si 基板

SRO/Pt下部電極Si基板 イメージ	薄膜層構成	標準膜厚仕様
	—	—
	—	—
	—	—
	下部SRO層	40nm ±10%
	下部Pt層	150nm ±10%
ZrO2層	60nm ±10%	

製品名	製品型番	基板サイズ	ベース基板厚
KRYSTAL Wafer-SRO/Pt-6-Si(100)	RF200-6C00	6inch	625 μm
KRYSTAL Wafer-SRO/Pt-8-Si(100)	RF300-8C00	8inch	725 μm

● Pt 下部電極 Si 基板

Pt下部電極Si基板 イメージ	薄膜層構成	標準膜厚仕様
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	下部Pt層	150nm ±10%
ZrO2層	60nm ±10%	

製品名	製品型番	基板サイズ	ベース基板厚
KRYSTAL Wafer-Pt-6-Si(100)	RF200-6B00	6inch	625 μm
KRYSTAL Wafer-Pt-8-Si(100)	RF300-8B00	8inch	725 μm

● ZrO2 バッファーSi 基板

ZrO2 バッファーSi基板 イメージ	薄膜層構成	標準膜厚仕様
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
ZrO2層	60nm ±10%	

製品名	製品型番	基板サイズ	ベース基板厚
KRYSTAL Wafer-ZrO2-6-Si(100)	RF200-6A00	6inch	625 μm
KRYSTAL Wafer-ZrO2-8-Si(100)	RF300-8A00	8inch	725 μm

連絡先:I-PEX Piezo Solutions 株式会社 横浜オフィス(営業所)
〒222-0033 横浜市港北区新横浜二丁目 3 番地 12 新横浜スクエアビル 11 階 (TEL: 045-472-7111)